SU 8光刻胶 负性光刻胶

产品名称	SU 8光刻胶 负性光刻胶
公司名称	苏州汶颢微流控技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Microchem 型号:2000系列3000系列 产地:进口
公司地址	苏州工业园区方洲路128号
联系电话	0512-62525802-8001 18136775672

产品详情

Microchem SU-8 2000/3000系列光刻胶的详细信息

SU 8光刻胶 负性光刻胶产品简介：

新型的化学增幅型负像
SU-8胶是一种负性、环氧树脂型、近紫外线光刻胶，克服了普通光刻胶采用 UV光刻导致的深宽比不足的问题，十分适合于制备高深宽比微结构。SU-8 光刻胶在近紫外光(365nm-400nm)范围内光吸收度很低，且整个光刻胶层所获得的曝光量均匀一致，可得到具有垂直侧壁和高深宽比的厚膜图形；它还具有良好的力学性能、抗化学腐蚀性和热稳定性。SU-8在受到紫外辐射后发生交联，是一种化学扩大负性胶，可以形成台阶等结构复杂的图形；且
SU-8胶不导电，在电镀时可以直接作为绝缘体使用。由于具有较多优点，SU-8胶正被逐渐应用于MEMS、芯片封装和微加工等领域。目前，直接采用
SU-8光刻胶来制备深宽比高的微结构与微零件已经成为微加工领域的一项新技术。

SU 8光刻胶 负性光刻胶光刻前清洗工艺：

为了获得更好的光刻效果，在进行光刻胶旋涂之前，需要对基材进行清洗。常用的清洗方法是利用浓硫酸及双氧水的混合溶液浸泡，随后用去离子水清洗并用氮气吹干。除此之外还可以利用反应离子刻蚀或等离子表面清洗仪清洗。

SU 8光刻胶 负性光刻胶光刻工艺：

将 SU-8光刻胶组分旋涂在基材上，旋涂厚度几至几百微米。涂覆晶片经过前烘并冷却至室温。在烘干过程中，优先选择加热均匀且温度控制精确的加热板；不能使用鼓风干燥箱，防止因为光刻胶表面优先固化从而阻止内层光刻胶溶剂的挥发。冷却后，将负光掩模与涂覆晶片接触并在汞灯的紫外辐射剂量10-250mJ/cm条件下进行曝光。曝光结束后，选择合适的烘烤温度及时间。将晶片在显影液中浸渍显影，随后用氮气吹干。

以及SU-8光刻胶相关产品：SU-8光刻胶显影液、SU-8光刻胶去胶液等。